汕头华汕电子器件有限公司

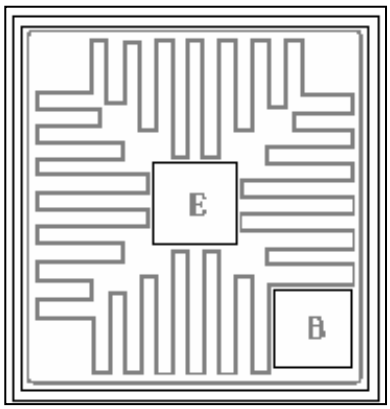
PNP SILICON TRANSISTOR

928S 晶体管芯片说明书

■ 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：A089BJ-01
芯片厚度：240±20μm
管芯尺寸：890×890μm^2
焊位尺寸：B 极 150×150μm^2；E 极 153×153μm^2
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：KSA928A，H928S

■ 管芯示意图



■ 极限值（T_a=25℃）（封装形式：TO-92）

T_{stg}——贮存温度…… -55~150℃
T_j——结温……150℃
P_C——集电极耗散功率……0.75W
V_{CBO}——集电极—基极电压……-30V
V_{CEO}——集电极—发射极电压……-30V
V_{EBO}——发射极—基极电压……-5V
I_C——集电极电流…… -2A

■ 电参数（T_a=25℃）（封装形式：TO-92）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-30			V	I_C=-100μA，I_E=0
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-30			V	I_C=-10mA，I_B=0
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I_E=-1mA，I_C=0
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	nA	V_{CB}=-30V，I_E=0
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	nA	V_{EB}=-5V，I_C=0
h_{FE}	直流电流增益	100		320		V_{CE}=-2V，I_C=-500mA
V_{CE}(sat)	集电极—发射极饱和电压			-2	V	I_C=-1.5A，I_B=-30mA
V_{BE}(on)	基极—发射极导通电压			-1	V	V_{CE}=-2V，I_C=-500mA
f_T	特征频率		120		MHz	V_{CE}=-2V，I_C=-500mA
C_{ob}	共基极输出电容		30		pF	V_{CB}=-10V,I_E=0,f=1MHz